

⑨日本国特許庁
公開特許公報

⑪特許出願公開
昭52—88581

⑫Int. Cl.³ 識別記号
B 01 D 53/20 // B A A
B 01 D 3/28
B 01 J 1/00

⑬日本分類 庁内整理番号
13(7) B 011.21 6949—4A
13(7) B 29 6675—4A
13(7) B 611 7404—4A

⑭公開 昭和52年(1977)7月25日
発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑮物質代謝塔用の充填材

⑯特 願 昭51—148808
⑰出 願 昭51(1976)12月13日
優先権主張 ⑱1976年1月16日⑲スイス国⑳
490/76
㉑発 明 者 マックス・フーバー

スイス国ウインターツール・マ
イテンシュトラッセ38
㉒出 願 人 ゲブリューダー・ズルツァー・
アクチエンゲゼルシャフト
スイス国ウインターツール(番
地なし)
㉓代 理 人 弁理士 浅村皓 外3名

明 細 書

1. 発明の名称

物質代謝塔用の充填材

2. 特許請求の範囲

1. 塔軸線に平行に配置され相接触し、波形溝を付けられた薄層物から成っており、その場合薄層物波形溝は塔軸線に対し傾斜し、かつ隣接する薄層物はそれらの波形溝が交差するように配置されており、かつその場合垂直に配置された薄層物は塔軸線に対し傾斜した、間隔をおいて配置された孔の列を有している、物質代謝塔用の充填材において、波形溝を付けられていない状態において隣接する、重疊した孔列の孔は相互偏位されている、最上方の孔列の夫々2個の孔の間にある階下路はその下方にある孔列の孔に突き当たるようになることを特徴とする充填材。
2. 特許請求の範囲第1項に記載の充填材において、重疊した孔列の孔は孔直径よりも大なる距離だけ相互偏位していることを特徴とする充填材。
3. 特許請求の範囲第2項に記載の充填材におい

て、重疊した孔列の場合次の下の孔列の孔は次の上の孔列の夫々2個の孔の中心に位置していることを特徴とする充填材。

3. 発明の詳細な説明

本発明は塔軸線に平行に配置され相接触し、波形溝を付けられた薄層物から成っており、その場合薄層物波形溝は塔軸線に対し傾斜しかつ隣接する薄層物はそれらの波形溝が交差するように配置されており、かつその場合垂直に配置された薄層物は塔軸線に対し傾斜した、間隔をおいて配置された孔の列を有している、物質代謝塔用の充填材に関する。

この種充填材を、精留、吸収、抽出および例へば化学的代謝反応による物質からのアイソトープ元素の分離、例へばドイテリウムおよび水素の分離のような化学的反応の実施に使われる物質代謝塔内に配置することは公知である。

この場合薄層物は例へば金属、例へばステンレススチールからまたはプラスチックからあるいは自動湿潤する織物または絹物から成ることができ

る。

公知の充填材の場合今までは、バンド片から裁断される薄層物は波形溝を付ける前に穿孔し、つまり波形溝を付けられていないバンドはバンドの幅にわたって分配された、間隔をおいて配置された孔の数列の列を有し、その場合隣接する孔列の孔は夫々バンド軸線に垂直の孔列を形成するのが普通であつた。これらの孔は充填材の横断面にわたつたガス代謝の改良を招くためならびに塔軸線に沿う圧力低下を減少させるために備えられた。

垂直の流動面を有する緩徐流動充填材の場合には他の孔配置も公知である。例へば隣接する孔列は相互の孔間隔の半分だけバンドの縦方向に転置されていることができる。この孔配置は後述される如く液体のより良い拡張を実現する。

バンドの斜めの波形溝の場合波形溝を付けられていないバンドの中でバンド軸線に垂直に位置する孔列はバンド軸線に対しある角度を成すようになる。すなわち波形溝付きのバンドの垂直の状態においては、1列の孔は隣接する孔列の孔に対し水

直に重疊した孔は相互偏位しているからである。然るに実験はかくの如きではないことを示した。しかして本発明は、望ましくない液体の流路を実現するフリーの降下路の形成に関する関係は斜めに波形溝を付けられた薄層物においても変化しないという認識を基調とする。平滑なバンドにおいて垂直に経過する降下路は波形溝側面の方に波形溝を付けられた薄層物においても生ずる。これによつて降下路は薄層物に平行の面上の投影図において溝の無いバンドの中の垂直の孔列が有するのと同じ傾斜を有する。すなわち液体の流動状態は両者の場合同じである。この事実は後でなお図面に表わされた例によつて示される。

本発明は薄層物の適当な形成によつて充填材の流入横断面上に該入された液体の側方への拡張を改善し、すなわち流路形成を回避しかつ薄層物表面上の液体の側方拡張によつて薄層物表面の均等な浸潤を企図することを課題とする、実験上の理由によつて、初めから液体を全薄層物の表面にわたつて均等に分配することは可能ではない。その

特開 昭52-85581 (2)

平方方向に相互偏位されている。

この理由によりこの穿孔は特に有利に見られ、波形溝の無いバンド中の他の孔配置において波形溝を付けた後孔は塔軸線に対し垂直の列内に位置するようになることができる。

しかるに公知の充填材においては、薄層物表面にわたる液体の分配が塔の中を下方へ流れる液体の相によつては満足な結果には達成されないことが示された。公知の、波形溝の無い垂直のバンド上の孔列の配置の場合孔列の垂直に重疊した孔の間でいわゆる降下路の中に液体の流路が生ずる、すなわち液体は垂直の降下路に沿つて側方への拡張なしに阻害されずに降下路の中を流れるからである。しかしてバンド上に斜めの波形溝を取付けて塔軸線に平行に配置された薄層物が形成される場合波形溝の無いバンドにおいて垂直に経過している孔列は塔軸線に対してある角度を成すことによつて今までは、薄層物表面にわたつて液体の側方への拡張が生ずるものと考えられた、すなわち波形溝の無いバンドにおいて隣接する孔列の、垂

外偶然の故障によつて液体が再び大なる流路に集合することを常に予期しなければならない。

この課題は本発明にあづき、波形溝の無い状態において重疊した隣接の孔列の孔は相互偏位されていて、上方の孔列の夫々2個の孔の間にある降下路はその下方にある孔列の孔に突き当たるようになることによつて解決される。液体が溢流してはならない孔の寸法に関しては約2-6mmの大きさの孔直径が有利であることが証明された。

本発明の有利な実施型においては、相互重疊している孔列は孔直径よりも大なる距離だけ相互偏位しており、また本発明の特に有利な実施型においては、重疊した孔列は孔間隔の半分だけ相互転置して配置されている。

波形溝の無いバンドの中の本発明による孔の配置にあづき、降下路の中には常に最上列の下方に配置された孔列の孔が位置している。これによつて波形溝の無い垂直のバンドの上で既に当該孔の線において液体の側方への転向が行われる。前述の如く、この流動状態はバンドに斜めの波形溝を

取付けた後でも変化せず、すなわち充填材を形成する薄層物の表面上において薄層物表面にわたる液体の均等な側方の拡張が満足される規模に保証されている。

本発明によつて達成される効果は、孔すべてが同じ直径を有すること、または並置した孔列の垂直距離は到る所同一であることを前提としないことを指摘しておく。

実験によると、穿孔に際して、有効な物質代謝のために決定的な十分に大なる浸潤される表面を得るために、1個の薄層物の全部の孔の面積は穿孔されていない薄層物表面に対して5-20%の大きさであることに注意するのが有利なことである。

その箇所でも有効になる毛細管力によつて形成されることがある波形溝谷に沿う液体の万一の流路形成を確実に避けるためには、格納部に対し傾に配置された孔列の孔距離を、この孔距離が波形溝の波の長さに対して単純な比例を成さないよう、換言すれば波の長さに対する孔距離の商が1, 2, 3などにはならないように選択するのが有利である。

れた平滑のバンド1から形成された薄層物の切片1'を示す、第1b図に表われている如く波形溝付きの薄層物1'上の流動関係は平滑なバンド1におけるものと同一である、すなわち降下線は垂直線に対しある角度を成しているけれども同じ孔が降下線に突き当たり、一方孔の間には降下路gが形成されている。これに対しかかる液体の流路形成は第2a図が示すような本発明により穿孔されたバンド4においては避けられる、すなわち最上方の孔列の夫々2個の孔5の間にある降下路の中には下方にある孔列の孔があるからである。液体流は孔列において側方へ転向せられ(矢印参照)かつバンドの穿孔されていない表面にわたつて拡張する。

この流動関係は斜めの波形溝の構造によつても得られるが故に波形溝付きの薄層物4'の表面も完全に浸潤される。図示された実施例(第2a, 2b図参照)においては波形溝は第1b図と第1c図におけるのと同じ傾斜と波形幅とを有する。

第2b図と第2c図に相応して形成された薄層

る。

すなわちこれによつて、薄層物表面にわたつて統計的に分配されて配置された孔の若干数が常に波形溝谷の範囲内に位置するようになることが保証される。

以下図面に表わされた実施例によつて本発明を詳述する。

第1a図による、今までの普通の方法で穿孔されたバンドの切片は孔2を有する並置した孔列を有し、その場合バンドを垂直の状態に直立させた波形溝を付けられていない薄層物として見る時隣接した孔列の孔は垂直に位置しており、その場合水平の孔列の孔は同じ間隔aに配置されている。図面によると、降下線gに接する孔の間には降下路gが形成され、この降下路の中を液体は阻害されず、側方への拡張無しに下方へ流れる。

並置した孔の間の面は少なくとも広範囲に不浸潤に止つてゐる。

第1b図は垂直線に対し傾斜した、波の長さwの波形溝3を有する薄層物で、第1a図に表わさ

れた物4'から構造された充填材7を第3図が示している。この場合薄層物4'は、続いて重ねられかつ充填材7に併合されかつ次いでシリンダー状の格の物質代謝部分の中に充填される順序に表わされている。図面によると個々の部分の薄層物の大きさが相違していて両外側から中心に向つて増大しており、薄層物は組合せによつてシリンダー状の体を生ずる。

第4図には、夫々相互90°偏位して配置された3個の充填要素を含んでいる格の物質代謝部分の切片8が表わされている。この場合薄層物は例へばシートから成ることができる。

4 図面の簡単な説明

第1a図、第1b図、第1c図は夫々、今までの普通の方法で穿孔されたバンドの片片、波形溝を付けられた状態のバンドおよびこのバンドの1c-1c線に沿う断面の図形、第2a図、第2b図、第2c図は本発明の実施例の図形、第3図は充填材の個々の薄層物の見取図、第4図は3個の充填材を有する物質代謝格の一部を示す。

図面の主な符号の説明

1, 4: 穿孔されたバンド、2, 5: 孔、3, 3':
 波形溝、4': 薄層物、f, f': 隆下線、g, g':
 隆下路。

代理人 浅 村 皓
 外 3 名

Fig. 1a

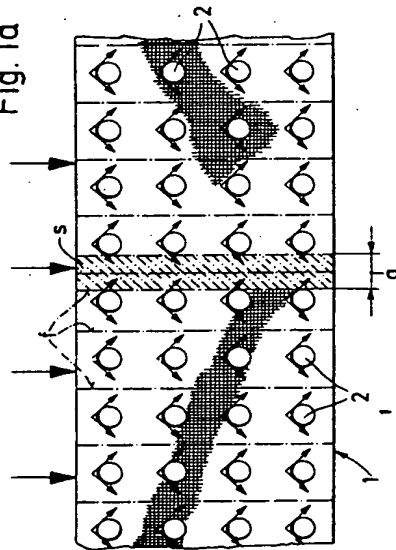


Fig. 1b

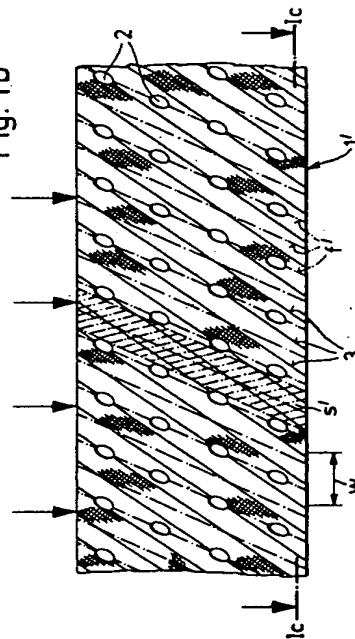
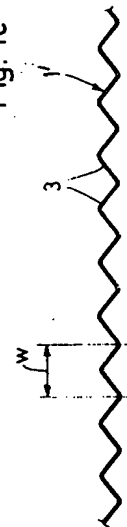


Fig. 1c



(5)

特開 昭52-00091 (5)

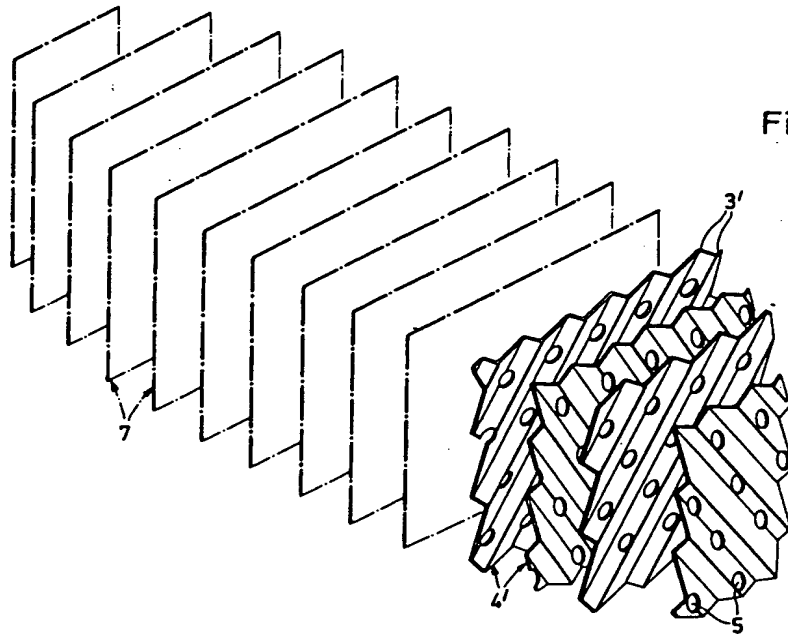
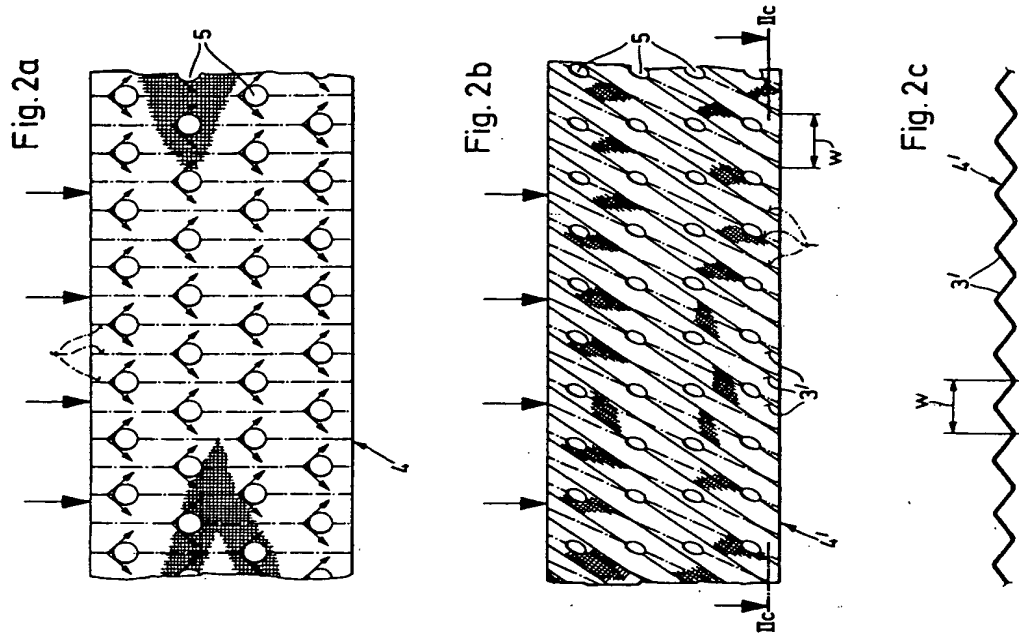
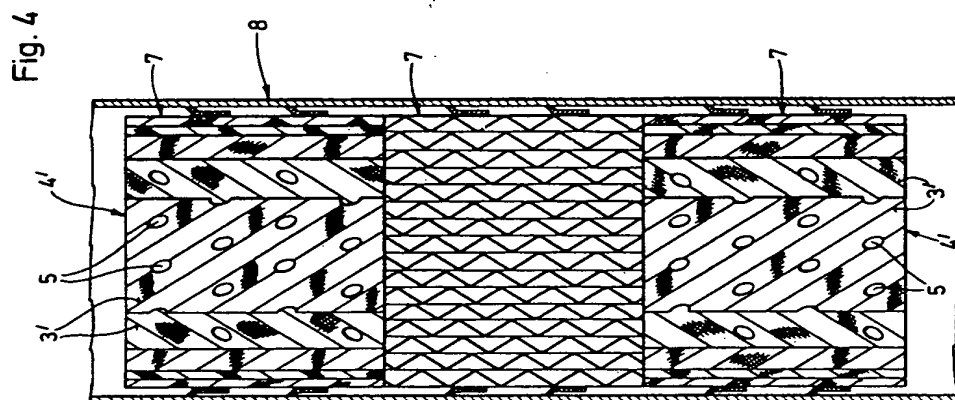


Fig. 3

(6)

特開 昭52- 88581(6)



昭 55 11.21 発行

特許法第17条の2による補正の掲載
 昭和 51 年特許願第 148808 号(特開昭
 52- 88581号 昭和52年7月25日
 発行公開特許公報 52- 886 号掲載)につ
 いては特許法第17条の2による補正があったので
 下記の通り掲載する。

Int.Cl.	種別 記号	庁内整理番号
B01D 53/20		6825 4D
3/24		2126 4D

手 続 補 正 書

昭和 55 年 7 月 13 日 特許正

特許庁長官殿

1. 事件の表示
 昭和 51 年特許願第 148808 号

2. 発明の名称
 物質代調塔用の充填材

3. 補正をする者
 事件との関係 特許出願人
 住 所
 氏 名 ゲブリューダー、メルツァー
 (名 称) アクチエンゲゼルシャフト

4. 代 理 人
 居 所 平100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
 新 大 手 町 ビ ル デ ィ ン グ 3 3 1
 電 話 (211) 3 6-5 1 (代 表)
 氏 名 (6669) 浅 村 皓

5. 補正命令の日付

昭和 年 月 日 特許庁
 55.7.13
 特許第二課

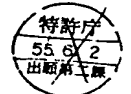
6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の欄

8. 補正の内容 別紙のとおり

9. 添付書類の目録 同時に出版審査請求書を出してあります。



(特許請求の範囲第2項および第3項を削除する。)

2. 特許請求の範囲

塔軸線に平行に配置され相接触し、波形溝を付
 けられた薄層物から成っており、その場合薄層物
 波形溝は塔軸線に対し傾斜し、かつ隣接する薄層
 物はそれらの波形溝が交差するように配置されて
 おり、かつその場合垂直に配置された薄層物は塔
 軸線に対し傾斜した。間隔において配置された
 孔の列を有している。物質代調塔用の充填材にお
 いて、波形溝を付けられていない状態において隣
 接する、重畳した孔列の孔は相互偏位されていて、
 最上方の孔列の夫々2個の孔の間にある降下路は
 その下方にある孔列の孔を通つて延びるようにな
 ることを特徴とする充填材。